

	(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)	(11) 공개번호 10-2012-0038818 (43) 공개일자 2012년04월24일
(51) 국제특허분류(Int. Cl.) C09K 11/06 (2006.01) H01L 51/50 (2006.01)		(71) 출원인 엘지디스플레이 주식회사 서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)
(21) 출원번호 10-2010-0100484		(72) 발명자 정현철 경상남도 하동군 양보면 감당리 1002
(22) 출원일자 2010년10월14일 심사청구일자 없음		이승재 경기도 고양시 일산동구 강촌로 166, 901동 802호 (백석동, 백송마을) (뒷면에 계속)
		(74) 대리인 특허법인네이트

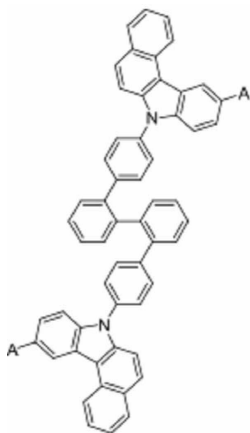
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 적색 인광 호스트 물질 및 이를 이용한 유기전계발광소자

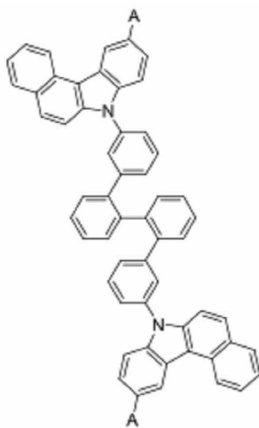
(57) 요약

본 발명은 하기 화학식1 또는 화학식2로 표시되며, A는 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 이형고리 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 또는 수소에서 선택되는 것이 특징인 유기전계발광소자용 적색 인광 호스트 물질을 제공한다.

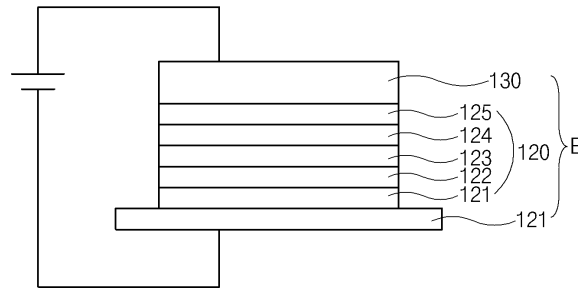
화학식1



화학식2



대표도 - 도2



(72) 발명자

김중근

서울특별시 영등포구 당산로 214, 삼성래미안4차아파트 404동 2501호 (당산동5가)

박춘건

경기도 파주시 월롱면 덕은리 파주LCD산업단지 1007번지

빈중관

경기도 파주시 동패로 117, 204동 1401호 (동패동, 교하벽산아파트)

양중환

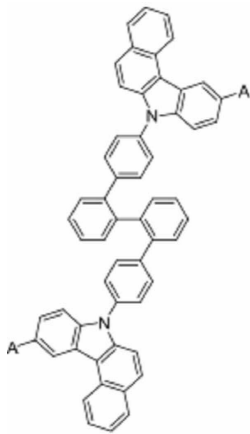
경기도 광명시 디지털로 64, 106동 1701호 (철산동, 철산한신아파트)

특허청구의 범위

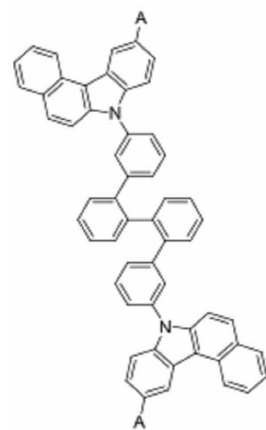
청구항 1

하기 화학식1 또는 화학식2로 표시되며, A는 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 이형고리 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 또는 수소에서 선택되는 것이 특징인 유기전계발광소자용 적색 인광 호스트 물질.

화학식1



화학식2



청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 방향족 그룹 물질은 페닐(phenyl), 나프틸(naphthyl), 바이페닐(biphenyl), 터페닐(terphenyl), 페난스렌닐(phenanthrenyl)을 포함하는 것이 특징인 적색 인광 호스트 물질.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 이형고리 그룹 물질은 피리딘일(pyridinyl), 비피리딘일(bipyridinyl), 퀴놀린일(quinolinyl), 이소퀴놀린일(isoquinolinyl), 퀴녹살린일(quinoxaliny), 터피리딘일(terpyridinyl), 페난스롤린일(phenanthrolinyl)을 포함하는 것이 특징인 적색 인광 호스트 물질.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 지방족 그룹 물질은 C1~C20의 아릴(aryl), C1~C20의 알킬(alkyl)을 포함하는 것이 특징인 적색 인광 호스트 물질.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 방향족 그룹 물질, 상기 이헥고리 그룹 물질 및 상기 방향족 그룹 물질 각각의 치환체는 C1~C20의 아릴(aryl), C1~C20의 알킬(alkyl), C1~C20의 알콕시(alkoxy), 할로젠(halogen), 시아노(cyano), 실릴(silyl) 중에서 선택되는 것이 특징인 적색 인광 호스트 물질.

청구항 6

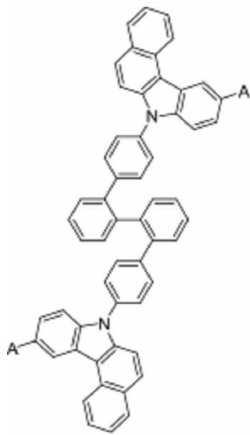
제 1 전극과;

상기 제 1 전극과 마주보는 제 2 전극과;

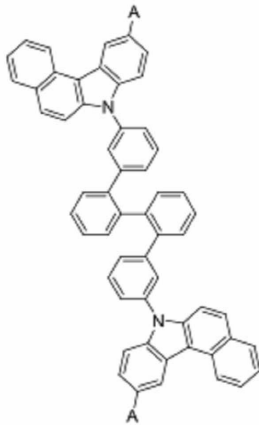
상기 제 1 및 제 2 전극 사이에 위치하는 발광물질층을 포함하고,

상기 발광물질층은, 하기 화학식1 또는 화학식2로 표시되며, A는 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 이헥고리 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 또는 수소에서 선택되는 것이 특징인 적색 인광 호스트 물질로 이루어지는 것이 특징인 유기전계발광소자.

화학식1



화학식2



청구항 7

제 6 항에 있어서,

상기 적색 인광 호스트 물질은 비극성 용매에 용해 가능하며 코팅 공정에 의해 형성되는 것이 특징인 유기전계 발광소자.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 적색 인광 호스트 물질 및 이를 사용하는 유기전계발광소자에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 용해가 가능하며 휘도 및 발광효율이 뛰어난 적색 인광 호스트 물질 및 이를 포함하여 이루어지는 유기전계발광소자에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 최근 표시장치의 대형화에 따라 공간 점유가 적은 평면표시소자의 요구가 증대되고 있는데, 이러한 평면표시소자 중 하나로서 유기발광다이오드(organic light emitting diode: OLED)라고도 불리는 유기전계발광소자의 기술이 빠른 속도로 발전하고 있으며, 이미 여러 시제품들이 발표된 바 있다.

[0003] 유기 전계 발광 소자는 전자 주입 전극(음극)과 정공 주입 전극(양극) 사이에 형성된 발광물질층에 전하를 주입하면 전자와 정공이 쌍을 이룬 후 소멸하면서 빛을 내는 소자이다. 플라스틱 같은 휘 수 있는(flexible) 투명 기관 위에도 소자를 형성할 수 있을 뿐 아니라, 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel)이나 무기 전계발광(EL) 디스플레이에 비해 낮은 전압에서 (10V이하) 구동이 가능하고, 또한 전력 소모가 비교적 적으며, 색감이 뛰어나다는 장점이 있다. 또한 유기 전계 발광(EL) 소자는 녹색, 청색, 적색의 3가지 색을 나타낼 수가 있어 차세대 풍부한 색 디스플레이 소자로 많은 사람들의 많은 관심의 대상이 되고 있다. 여기서 유기전계발광소자를 제작하는 과정을 간단히 살펴보면,

[0004] (1) 먼저, 투명기관 위에 인듐-틴-옥사이드(indium tin oxide; ITO)와 같은 물질을 증착하여 양극(anode)을 형성한다.

[0005] (2) 상기 양극 상에 정공주입층(HIL:hole injecting layer)을 형성한다. 정공주입층은 주로 하기 화학식1-1로 표시되는 구리 프탈로시아닌(copper phthalocyanine(CuPc))을 10nm 내지 30nm 두께로 증착하여 형성된다.

[0006] (3) 다음, 상기 정공주입층 상에 정공수송층(HTL: hole transport layer)을 형성한다. 이러한 정공수송층은 하기 화학식1-2로 표시되는 4,4'-bis[N-(1-naphtyl)-N-phenylamino]-biphenyl (NPD)을 30nm 내지 60nm 정도 증착하여 형성된다.

[0007] (4) 다음, 상기 정공수송층 상에 발광물질층(EML: emitting material layer)을 형성한다. 이때 필요에 따라

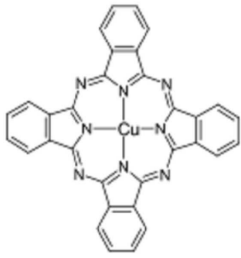
도펀트(dopant)를 첨가한다.

[0008] 예를 들어, 발광물질층은 적색 발광층 및 녹색 발광층, 청색 발광층이 하나의 픽셀을 구성하여 여러가지 계조(grayscale)을 표현하게 된다. 예를 들어, 적색(green) 발광층은, 하기 화학식1-3으로 표시되는 4, 4' -N, N' -dicarbazolbiphenyl (CBP)를 30nm 내지 60nm의 두께로 증착하며 불순물(dopant)로는 하기 화학식 1-4 또는 1-5로 표시되는 이리듐 복합체가 주로 이용된다.

[0009] (5) 다음, 상기 발광물질층 상에 전자수송층(ETL:electron transport layer) 및 전자주입층(EIL: electron injecting layer)을 연속적으로 형성한다. 이때, 상기 전자수송층은 하기 화학식1-6으로 표시되는 tris(8-hydroxy-quinolate)aluminum (Alq3)로 이루어진다.

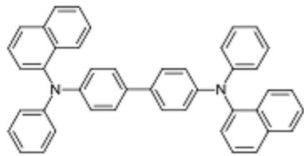
[0010] (6) 다음, 상기 전자주입층 상에 음극(cathode)을 형성하고, 마지막으로 상기 음극 상에 보호막을 형성한다.

[0011] 화학식1-1



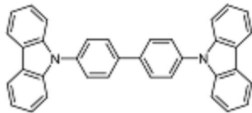
[0012]

[0013] 화학식1-2



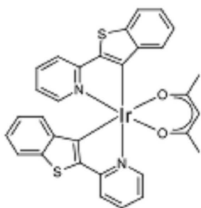
[0014]

[0015] 화학식1-3



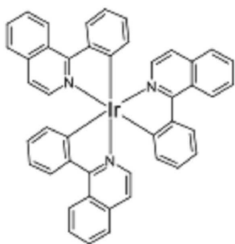
[0016]

[0017] 화학식1-4



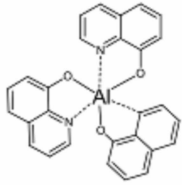
[0018]

[0019] 화학식1-5



[0020]

[0021] 화학식1-6



[0022]

[0023] 상기와 같은 구조에 있어 발광물질층은 청색, 녹색, 적색을 구현하여, 풀컬러의 화상을 구현하게 된다.

[0024] 발광 재료의 경우 양쪽 전극에서부터 주입된 전자와 정공의 재결합에 의해 여기자가 형성되며, 일중항 여기자의 경우 형광, 삼중항 여기자의 경우 인광에 관여하게 된다. 인광재료에 관여하는 생성확률이 75%인 삼중항 여기자의 경우 생성확률이 25%인 일중항 여기자를 사용하는 형광재료보다 뛰어난 발광효율을 보인다. 이러한 인광재료 중 적색 인광 재료는 형광재료에 비해 매우 높은 발광효율을 가질 수 있으므로 유기전계발광소자의 효율을 높이는 중요한 방법으로 많이 연구되고 있다.

[0025] 인광 재료를 이용하기 위해서는 높은 발광효율, 높은 색순도, 긴 발광수명이 요구되며, 이중 적색의 경우 도 1과 같이 색순도가 높아질수록(CIE 색좌표 X값이 커질수록) 시감도가 떨어지기 때문에, 동일한 내부양자효율로는 높은 발광효율을 얻기 어려운 문제가 있다. 이에 따라 우수한 색순도(CIE색순도 $X=0.65$ 이상)와 높은 발광효율을 가지는 적색 인광 물질의 개발이 요구되고 있다.

[0026] 한편, 적색 인광 호스트 물질로는 CBP 또는 금속 복합체(metal complex) 등이 사용되고 있으나, 이러한 물질들은 용해도가 좋지 않아 증착 공정을 통해 형성되어야 하므로 공정 효율이 떨어지는 단점을 갖는다.

[0027] 특히 대면적 소자를 형성하는데 큰 한계를 갖는다.

발명의 내용

해결하려는 과제

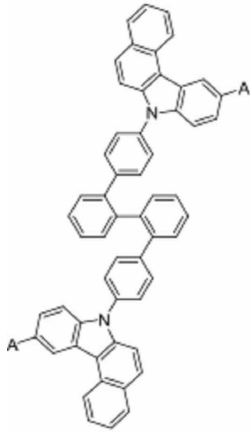
[0028] 본 발명은 용해도가 뛰어나 용액 공정이 가능하고, 휘도 및 발광효율이 뛰어난 적색 인광 호스트 물질을 제공하고자 한다.

[0029] 또한, 상기 적색 인광 호스트 물질을 이용하여 고휘도의 영상을 구현할 수 있는 대면적 유기전계발광소자를 제공하고자 한다.

과제의 해결 수단

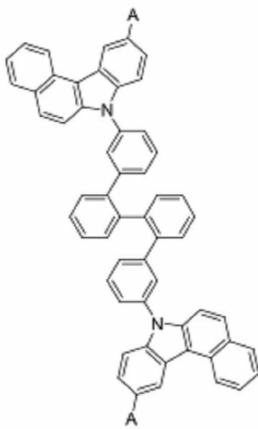
[0030] 위와 같은 과제의 해결을 위해, 본 발명은 하기 화학식1 또는 화학식2로 표시되며, A는 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 이헥고리 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 또는 수소에서 선택되는 것이 특징인 유기전계발광소자용 적색 인광 호스트 물질을 제공한다.

[0031] 화학식1



[0032]

[0033] 화학식2



[0034]

[0035] 상기 방향족 그룹 물질은 페닐(phenyl), 나프틸(naphthyl), 바이페닐(biphenyl), 터페닐(terphenyl), 페난스렌닐(phenanthrenyl)을 포함하는 것이 특징이다.

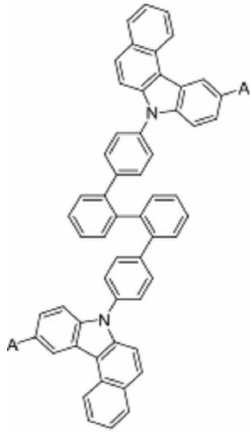
[0036] 상기 이형고리 그룹 물질은 피리딘일(pyridinyl), 비피리딘일(bipyridinyl), 퀴놀린일(quinolinyl), 이소퀴놀린일(isoquinolinyl), 퀴녹살린일(quinoxaliny), 터피리딘일(terpyridinyl), 페난스롤린일(phenanthrolinyl)을 포함하는 것이 특징이다.

[0037] 상기 지방족 그룹 물질은 C1~C20의 아릴(aryl), C1~C20의 알킬(alkyl)을 포함하는 것이 특징이다.

[0038] 상기 방향족 그룹 물질, 상기 이형고리 그룹 물질 및 상기 지방족 그룹 물질 각각의 치환체는 C1~C20의 아릴(aryl), C1~C20의 알킬(alkyl), C1~C20의 알콕시(alkoxy), 할로겐(halogen), 시아노(cyano), 실릴(silyl) 중에서 선택되는 것이 특징이다.

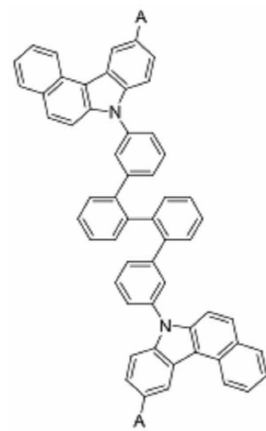
[0039] 다른 관점에서, 제 1 전극과; 상기 제 1 전극과 마주보는 제 2 전극과; 상기 제 1 및 제 2 전극 사이에 위치하는 발광물질층을 포함하고, 상기 발광물질층은, 하기 화학식1 또는 화학식2로 표시되며, A는 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 이형고리 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 지방족 그룹 물질, 또는 수소에서 선택되는 것이 특징인 적색 인광 호스트 물질로 이루어지는 것이 특징인 유기전계발광소자를 제공한다.

[0040] 화학식1



[0041]

[0042] 화학식2



[0043]

[0044] 상기 적색 인광 호스트 물질은 비극성 용매에 용해 가능하며 코팅 공정에 의해 형성되는 것이 특징이다.

발명의 효과

[0045] 본 발명의 적색 인광 호스트 물질은 용해도가 뛰어나기 때문에, 용액 공정에 의해 필름 형성이 가능한 장점을 갖는다. 이에 따라 대면적 유기전계발광소자의 제조가 용이하다.

[0046] 또한, 상기 적색 인광 호스트 물질을 이용하는 유기전계발광소자는 고휘도의 영상을 구현할 수 있고 또한 전력 소모가 감소되는 효과를 갖는다.

도면의 간단한 설명

[0047] 도 1은 유기전계발광소자의 색순도와 시감도(상대 민감도)의 관계를 보여주는 그래프이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광소자의 개략적인 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

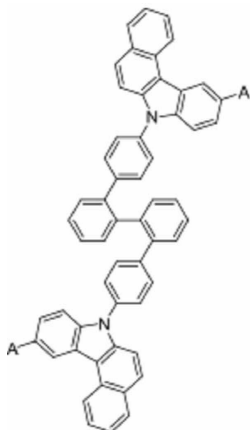
[0048] 이하, 본 발명에 따른 적색 인광 호스트 물질의 구조 및 그 합성예와, 이를 이용한 유기전계발광소자에 대해 설명한다.

[0049] - 제 1 실시예 -

[0050] 본 발명의 제 1 실시예에 따른 적색 인광 호스트 물질은 3,4번 위치에 벤조(benzo)기가 위치하고 6번 위치에 방향족 그룹, 이헥고리 그룹, 지방족 그룹 또는 수소로부터 선택된 물질이 치환되며 9번 위치에 페닐(phenyl)기가

치환된 카바졸(carbazol)이 바이페닐(biphenyl)에 대칭적으로 치환됨으로써, 솔루블한 특성을 갖는 것이 특징이며, 하기 화학식2로 표시된다. 카바졸의 질소는 페닐기의 para 위치에 치환된다.

화학식2



상기 화학식2에서 A는 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 이헥고리 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질 또는 수소에서 선택된다.

예를 들어, 상기 방향족 그룹 물질은 페닐(phenyl), 나프틸(naphthyl), 바이페닐(biphenyl), 터페닐(terphenyl), 페난스렌닐(phenanthrenyl)을 포함하는 것이 특징이다.

또한, 상기 이헥고리 그룹 물질은 피리딘일(pyridinyl), 비피리딘일(bipyridinyl), 퀴놀린일(quinolinyl), 이소퀴놀린일(isoquinolinyl), 퀴녹살린일(quinoxaliny), 터피리딘일(terpyridinyl), 페난스롤린일(phenanthrolinyl)을 포함하는 것이 특징이다.

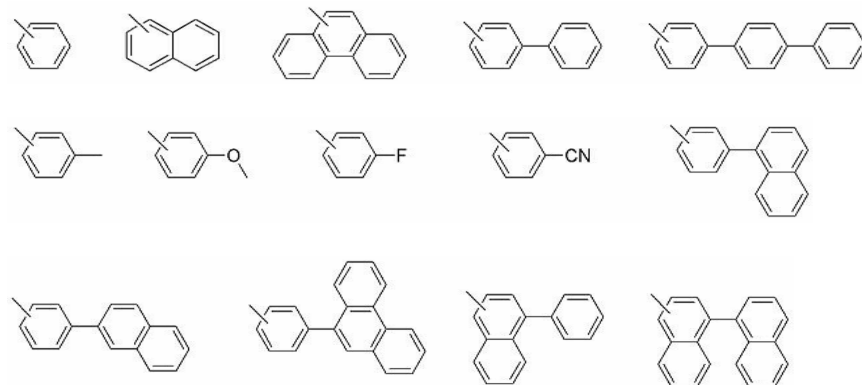
또한, 상기 지방족 그룹 물질은 C1~C20의 아릴(aryl), C1~C20의 알킬(alkyl)을 포함하는 것이 특징이다.

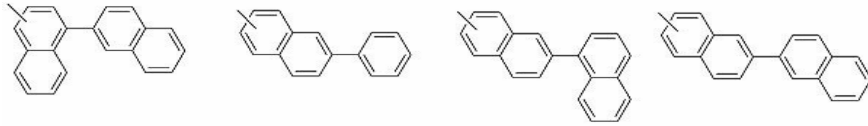
또한, 상기 방향족 그룹 물질, 상기 이헥고리 그룹 물질 및 상기 방향족 그룹 물질 각각의 치환체는 C1~C20의 아릴(aryl), C1~C20의 알킬(alkyl), C1~C20의 알콕시(alkoxy), 할로겐(halogen), 시아노(cyano), 실릴(silyl) 중에서 선택되는 것이 특징이다. 예를 들어, 상기 치환체는 메틸(methyl), 에틸(ethyl), 프로필(propyl), 이소프로필(isopropyl), 부틸(t-butyl), 메톡시(methoxy), 에톡시(ethoxy), 부톡시(butoxy), 트리메틸실릴(trimethylsilyl), 불소, 염소 중 어느 하나일 수 있다.

즉, 제 1 실시예의 적색 인광 호스트 물질은, 3,4번 위치에 벤조(benzo)기가 위치하고 6번 위치에 방향족 그룹, 이헥고리 그룹, 지방족 그룹 또는 수소로부터 선택된 물질이 치환되며 9번 위치에 페닐(phenyl)기가 치환된 카바졸(carbazol)이 바이페닐(biphenyl)에 대칭적으로 치환되며 카바졸의 질소는 페닐기의 para 위치에 치환됨으로써, 솔루블한 특성을 갖게 된다.

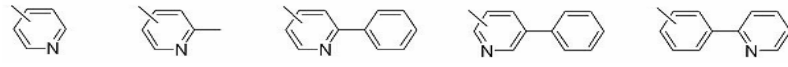
예를 들어, 상기 화학식2에서 A는 아래 화학식3으로 표시되는 다수의 물질군으로부터 선택될 수 있다.

화학식3

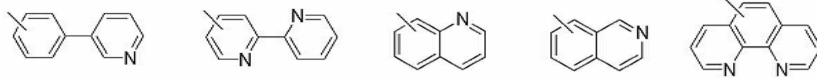




[0064]



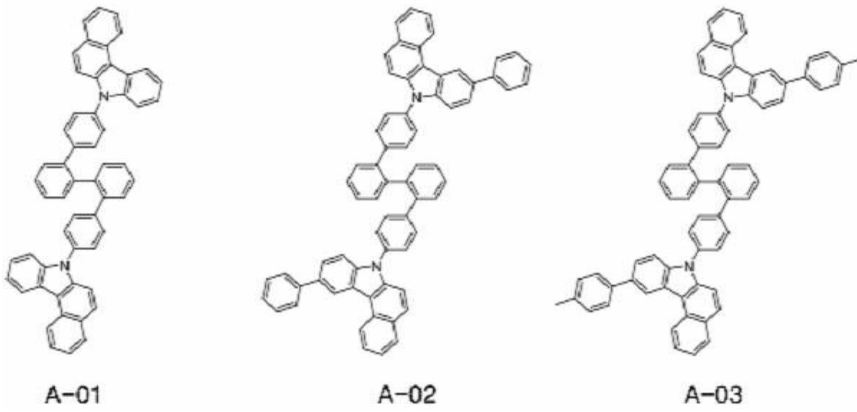
[0065]



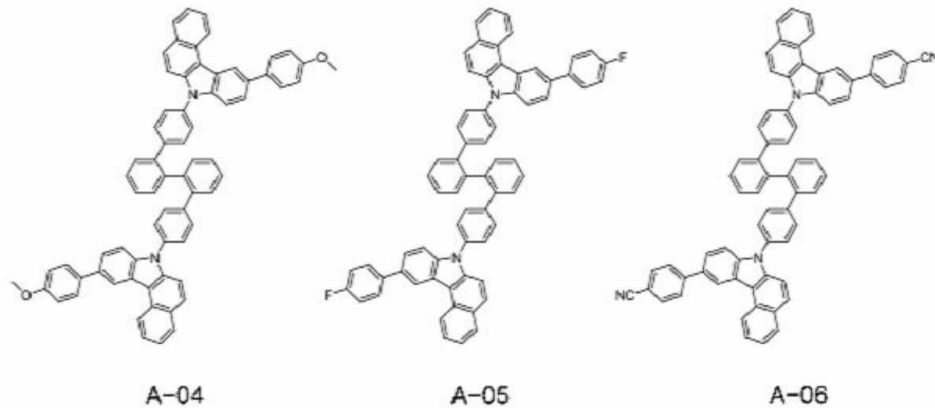
[0066]

[0067] A의 선택에 따라, 상기 화학식2의 적색 인광 호스트 물질은 하기 화학식4에 표시된 다수의 물질 중 어느 하나가 된다. 여기서, 설명의 편의를 위해 각 물질 하단에 A01~A38의 기호를 부여하였다.

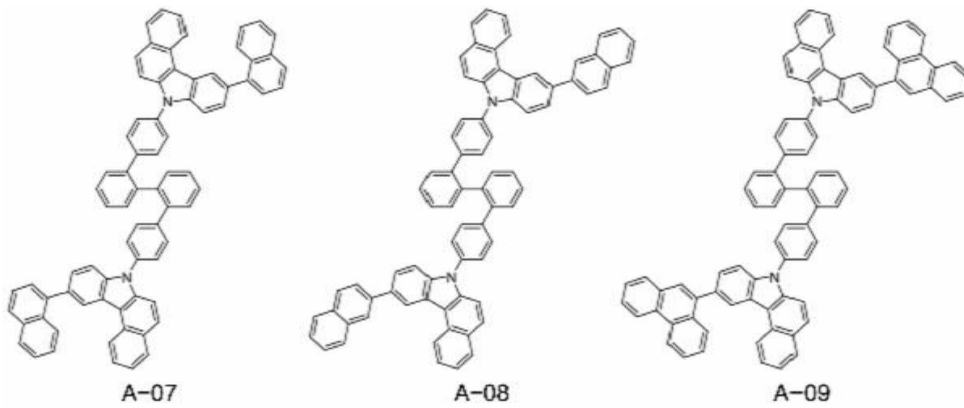
[0068] 화학식4



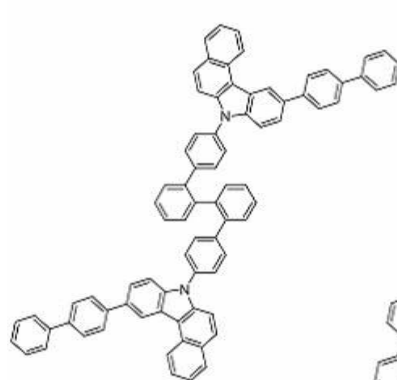
[0069]



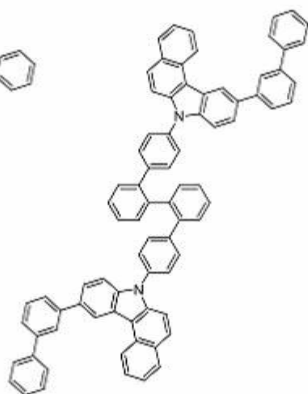
[0070]



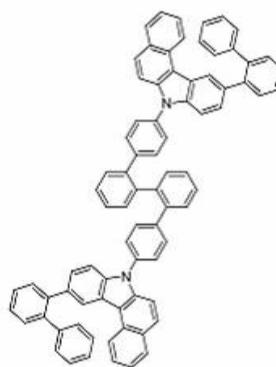
[0071]



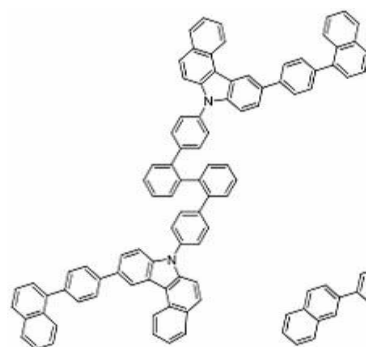
A-10



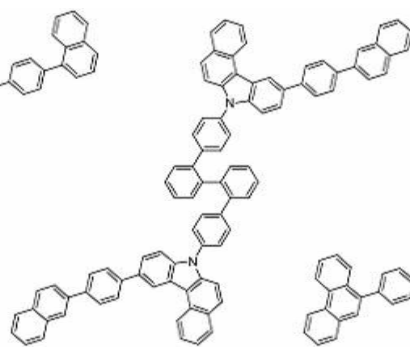
A-11



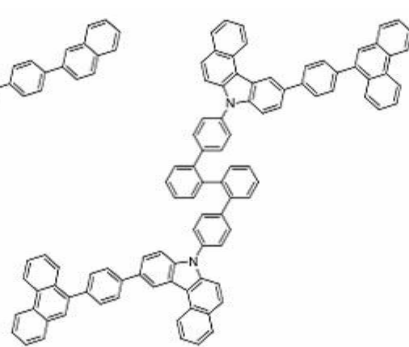
A-12



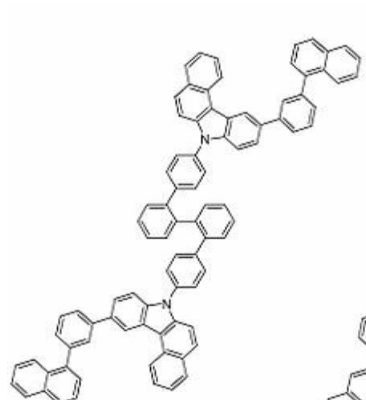
A-13



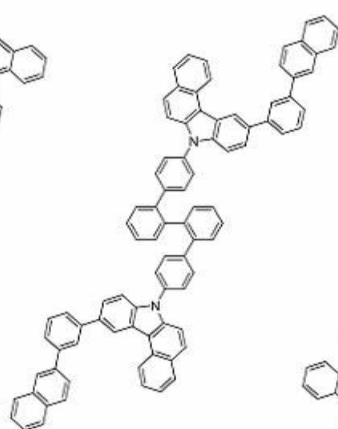
A-14



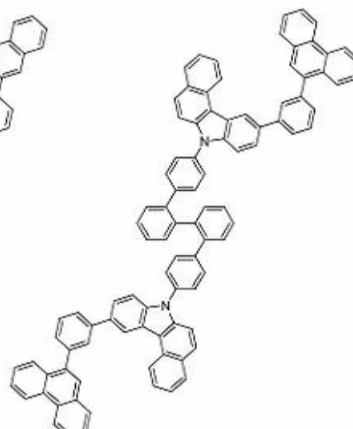
A-15



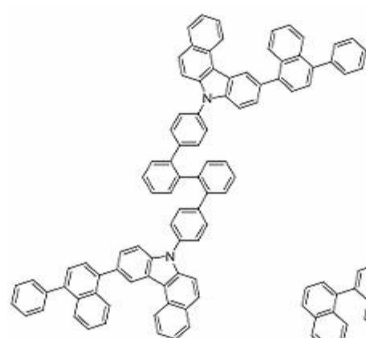
A-16



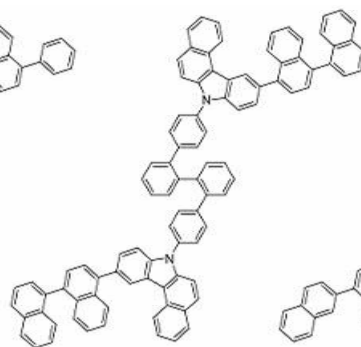
A-17



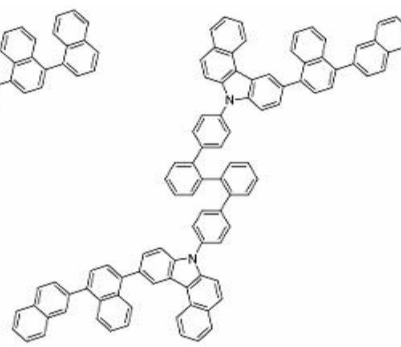
A-18



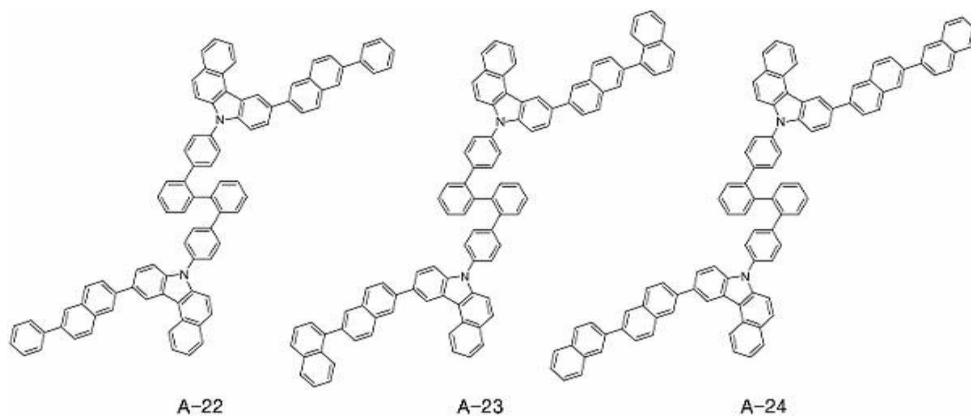
A-19



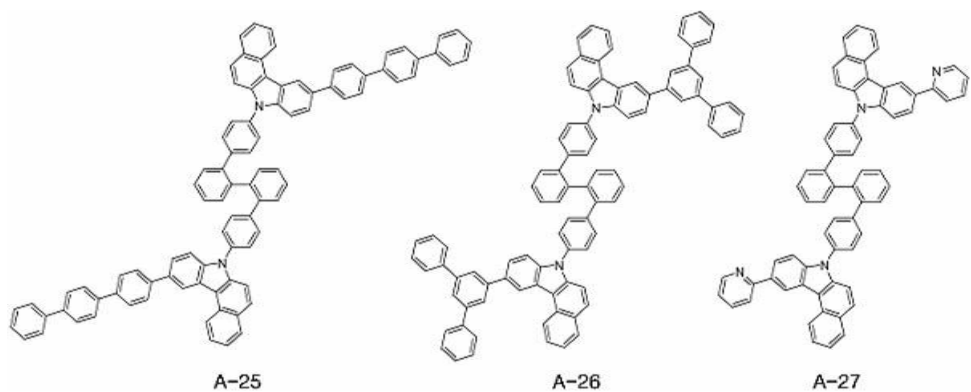
A-20



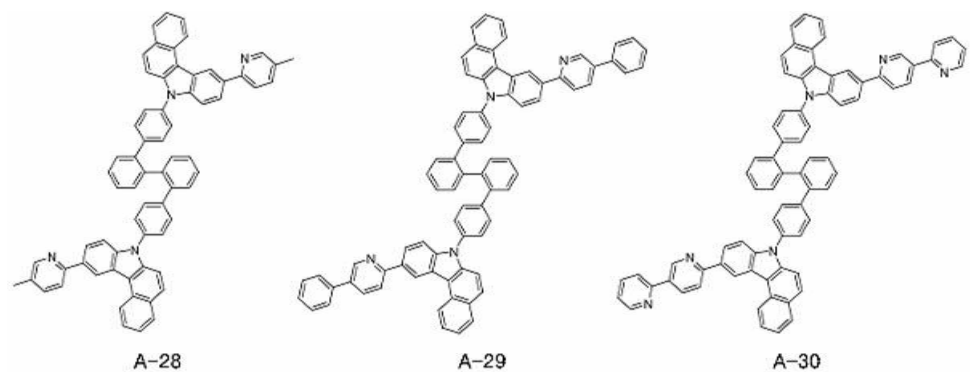
A-21



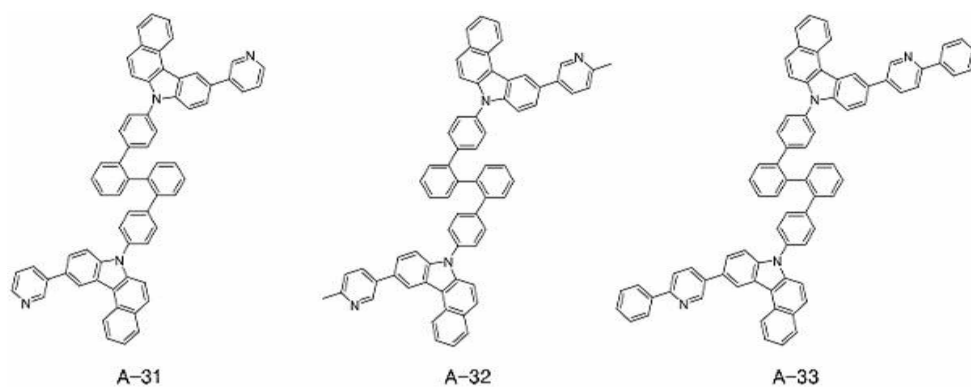
[0076]



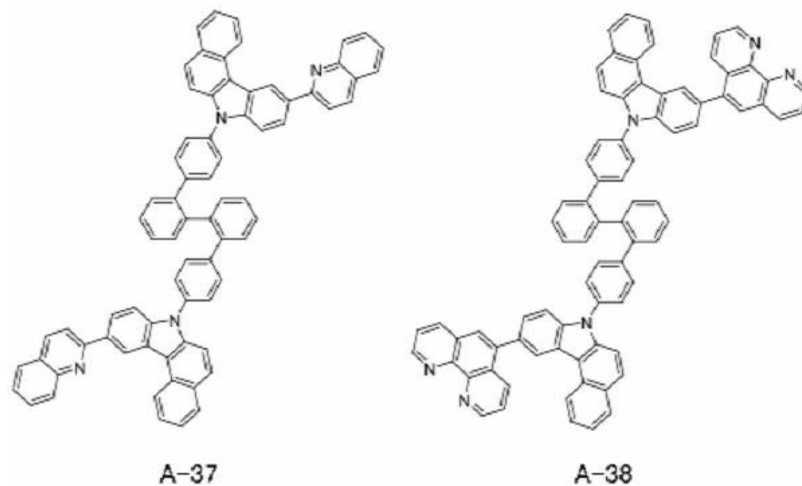
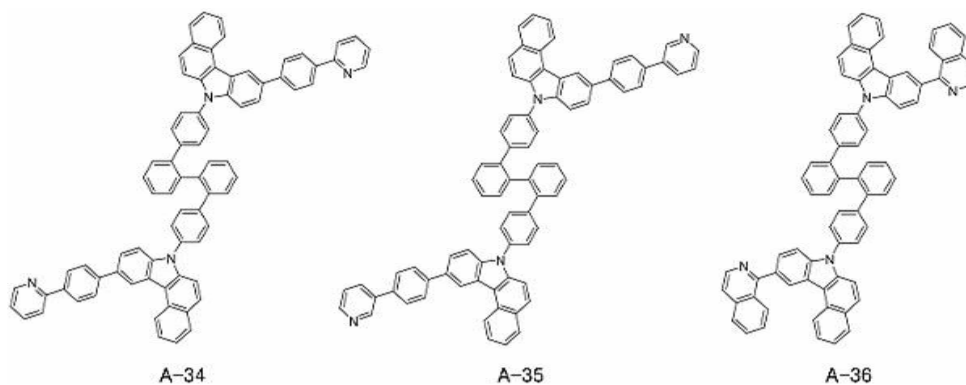
[0077]



[0078]



[0079]



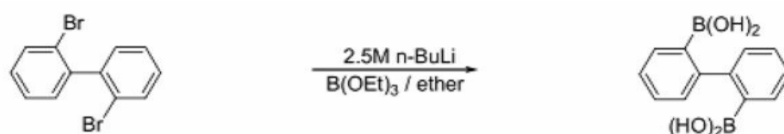
이하에서는, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기전계발광소자용 적색 인광 호스트 물질 중, 상기 화학식4에서 A-01과 A-02로 표시된 적색 인광 호스트 물질을 예로 들어, 합성예1 및 합성예2를 설명한다.

제 1 합성예

1. 2,2'-biphenyldiboronic acid의 합성

2,2'-biphenyldiboronic acid는 아래와 같은 반응식1에 의해 합성된다.

반응식1

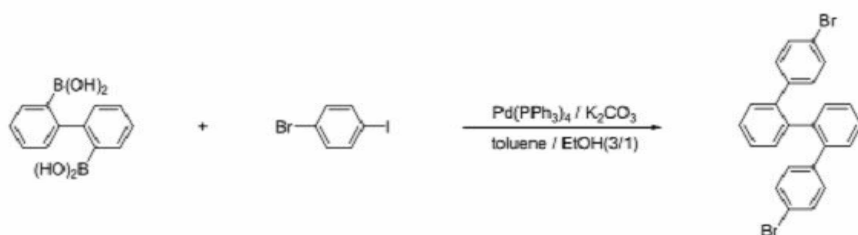


구체적으로, 2구 둥근 플라스크 (2-round flask)에 2,2'-dibromobiphenyl (10g, 0.03mol)과 100mL의 ether를 넣고 교반(stirring)한다. Dry-ice bath로 온도를 -78°C 로 내린 다음, 2.5M n-BuLi (26.9mL, 0.067mol)를 천천히 떨어뜨리고 (dropping) 다시 상온에서 1시간 동안 교반한다. 다시 dry-ice bath로 온도를 -78°C 로 내린 다음 triethylborate (19.5g, 0.13mol)를 천천히 떨어뜨리고 다시 상온에서 4시간 동안 교반한다. 100mL의 2N HCl를 넣고 반응을 종료(quenching)시킨 다음, 용매를 증발(evaporating)시킨다. 생성된 고체를 여과(filtering)하고, 증류수와 hexane으로 3-4회 세정(washing)하여 2,2'-biphenyldiboronic acid (5.4g, yield :70%)을 얻었다.

2. 2,2'-bis(4'-bromophenyl)biphenyl의 합성

2,2'-bis(4'-bromophenyl)biphenyl은 아래와 같은 반응식2에 의해 합성된다.

[0091] 반응식2



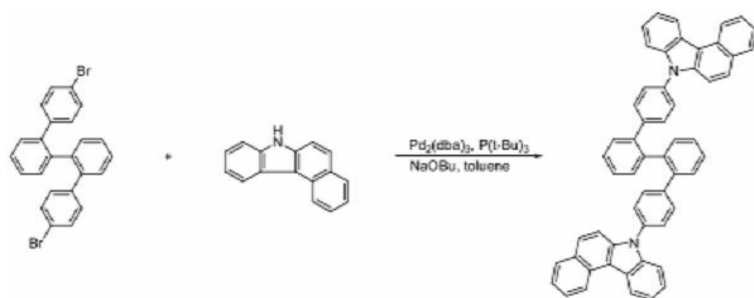
[0092]

[0093] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크에 2,2'-biphenyldiboronic acid (5g, 0.02mol), 1-bromo-4-iodobenzene(12.9g, 0.045mol), Pd(PPh₃)₄(0.1g, 0.9mmol), K₂CO₃과 90mL의 toluene/EtOH(3:1)를 넣고 12시간 동안 환류(reflux)시킨다. 온도를 상온(room temperature)으로 냉각한 다음, methylene chloride로 추출(extraction)하고, 용매를 증발시킨 후, 실리카겔 컬럼(silica gel column)으로 정제(purification)하여 2,2'-bis(4'-bromophenyl)biphenyl (7.8g, yield :80%)을 얻었다.

[0094] 3. A-01의 합성

[0095] 상기 화학식4에서 A-01로 표시된 적색 인광 호스트 물질은 아래와 같은 반응식3에 의해 합성된다.

[0096] 반응식3



[0097]

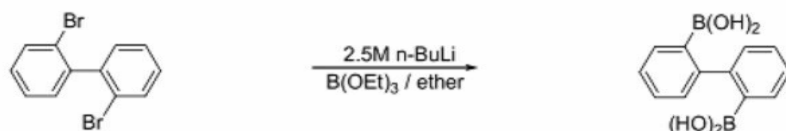
[0098] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크에 2,2'-bis(4'-bromophenyl)biphenyl (1g, 2.1mmol), benzo[3,4]carbazole (1g, 4.7mmol), Pd₂(dba)₃, P(t-Bu)₃, NaOBu(0.6g, 6mmol)와 toluene을 넣고 130℃에서 18시간 동안 환류시킨다. 온도를 상온으로 냉각한 다음, methylene chloride로 추출하고 용매를 증발시킨 후, 실리카겔 컬럼으로 정제하여 A-01(1.1g, yield :70%)을 얻었다.

[0099] 제 2 합성에

[0100] 1. 2,2'-biphenyldiboronic acid의 합성

[0101] 2,2'-biphenyldiboronic acid는 아래와 같은 반응식4에 의해 합성된다.

[0102] 반응식4



[0103]

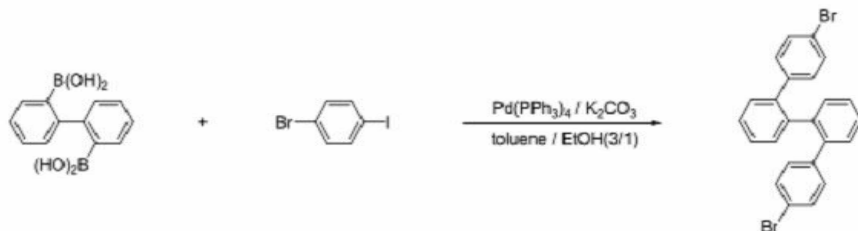
[0104] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크 (2-round flask)에 2,2'-dibromobiphenyl (10g, 0.03mol)과 100mL의 ether를 넣고 교반(stirring)한다. Dry-ice bath로 온도를 -78℃로 내린 다음, 2.5M n-BuLi (26.9mL, 0.067mol)를 천천히 떨어뜨리고 (dropping) 다시 상온에서 1시간 동안 교반한다. 다시 dry-ice bath로 온도를 -78℃로 내린 다음 triethylborate (19.5g, 0.13mol)를 천천히 떨어뜨리고 다시 상온에서 4시간 동안 교반한다. 100mL의 2N HCl를 넣고 반응을 종료시킨 다음, 용매를 증발(evaporating)시킨다. 생성된 고체를 여과(filtering)하고, 증류수와

hexane으로 3-4회 세정(washing)하여 2,2'-biphenyldiboronic acid (5.4g, yield :70%)을 얻었다.

[0105] 2. 2,2'-bis(4'-bromophenyl)biphenyl의 합성

[0106] 2,2'-bis(4'-bromophenyl)biphenyl은 아래와 같은 반응식5에 의해 합성된다.

[0107] 반응식5



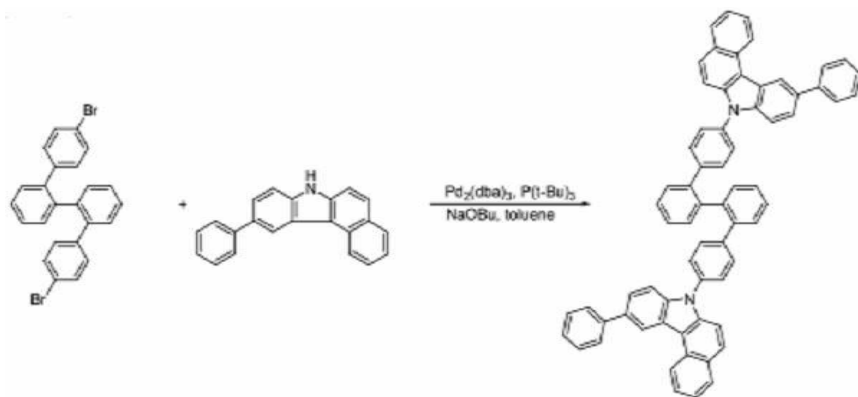
[0108]

[0109] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크에 2,2'-biphenyldiboronic acid (5g, 0.02mol), 1-bromo-4-iodobenzene(12.9g, 0.045mol), Pd(PPh3)4(0.1g, 0.9mmol), K2CO3과 90mL의 toluene/EtOH(3:1)를 넣고 12시간 동안 환류(reflux)시킨다. 온도를 상온(room temperature)으로 냉각한 다음, methylene chloride로 추출(extraction)하고, 용매를 증발시킨 후, 실리카겔 컬럼(silica gel column)으로 정제(purification)하여 2,2'-bis(4'-bromophenyl)biphenyl (7.8g, yield :80%)을 얻었다.

[0110] 3. A-02 의 합성

[0111] 상기 화학식4에서 A-02로 표시된 적색 인광 호스트 물질은 아래와 같은 반응식6에 의해 합성된다.

[0112] 반응식6



[0113]

[0114] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크에 2,2'-bis(4'-bromophenyl)biphenyl (1g, 2.1mmol), 3-phenylbenzo[3,4]carbazole (1g, 4.7mmol), Pd2(dba)3, P(t-Bu)3, NaOBu(0.6g, 6mmol)와 toluene을 넣고 130℃에서 18시간 동안 환류시킨다. 온도를 상온으로 냉각한 다음, methylene chloride로 추출하고 용매를 증발시킨 후, 실리카겔 컬럼으로 정제하여 A-02(1.1g, yield :70%)을 얻었다.

[0115] 이하, 상기한 본 발명의 제 1 실시예에 따른 적색 인광 호스트 물질을 이용하여 유기전계발광소자를 제작하는 실험예1 내지 실험예5을 통해, 본 발명에 의한 적색 인광 호스트 물질 및 이를 이용한 유기전계발광소자의 성능을 비교 설명한다.

[0116] 실험예1

[0117] 기관 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO층 CuPC (650Å), NPD(400Å), 상기 화학식4에서 A-01로 표시된 적색 인광 호스트 물질에 상기 화학식1-4로 RD-

1로 표시된 도펀트를 5% 첨가한 발광층 (200Å), Alq3(350Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

[0118] 0.9mA에서 1150cd/m²(5.8V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.658, y = 0.327를 나타내었다.

[0119] 실험예2

[0120] 기관 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 CuPC (650Å), NPD(400Å), 상기 화학식4에서 A-02로 표시된 적색 인광 호스트 물질에 상기 화학식1-4로 RD-1로 표시된 도펀트를 5% 첨가한 발광층 (200Å), Alq3(350Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

[0121] 0.9mA에서 1200cd/m²(5.7V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.659, y = 0.327를 나타내었다.

[0122] 실험예3

[0123] 기관 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 CuPC (650Å), NPD(400Å), 상기 화학식4에서 A-08로 표시된 적색 인광 호스트 물질에 상기 화학식1-4로 RD-1로 표시된 도펀트를 5% 첨가한 발광층 (200Å), Alq3(350Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

[0124] 0.9mA에서 1240cd/m²(5.8V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.658, y = 0.329를 나타내었다.

[0125] 실험예4

[0126] 기관 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 CuPC (650Å), NPD(400Å), 상기 화학식4에서 A-11으로 표시된 적색 인광 호스트 물질에 상기 화학식1-4로 RD-1로 표시된 도펀트를 5% 첨가한 발광층 (200Å), Alq3(350Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

[0127] 0.9mA에서 1280cd/m²(5.6V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.659, y = 0.330를 나타내었다.

[0128] 실험예5

[0129] 기관 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 PEDOT:PSS (800Å, spin coating : 3000 rpm, baking condition : 120 °C, for 1hr), 상기 화학식4에서 A-11로 표시된 적색 인광 호스트 물질에 상기 화학식1-4로 RD-1로 표시된 도펀트를 2% 첨가한 발광층 (250 Å, 3000 rpm, baking condition : 100 °C for 30min)로 스핀코팅 한 다음, Alq3(350Å), LiF(5Å) , Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

[0130] 0.9mA에서 1000cd/m²(6.5V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.658, y = 0.331를 나타내었다.

[0131] 비교예1

[0132] 기관 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 CuPC (650Å), NPD(400Å), 상기 화학식1-3으로 표시된 CBP에 상기 화학식1-4로 RD-1로 표시된 도펀트를 5% 첨가한 발광층 (200Å), Alq3(350Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

[0133] 0.9mA에서 790cd/m²(7.3V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.659, y = 0.330을 나타내었다.

[0134] 상술한 실험예1 내지 실험예5와 비교예의 비교결과를 아래 표1에 나타내었다. 여기서 전압의 단위는 V, 전류의 단위는 mA, 휘도의 단위는 cd/m², 전류효율의 단위는 cd/A, 전력효율의 단위는 lm/W, 내부양자효율의 단위는 % 이다.

표 1

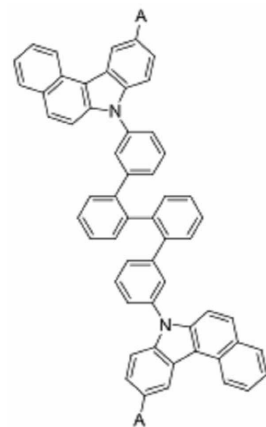
	전압	전류	휘도	전류효율	전력효율	내부양자 효율	CIE(X)	CIE(Y)
실시예1	5.8	0.9	1150	11.5	6.2	15.9	0.658	0.327
실시예2	5.7	0.9	1200	12.0	6.6	16.7	0.659	0.327
실시예3	5.8	0.9	1240	12.4	6.7	17.3	0.658	0.329
실시예4	5.6	0.9	1280	12.8	7.2	17.7	0.659	0.330
실시예5	6.5	0.9	1000	10.0	4.3	14.6	0.658	0.331
비교예1	7.3	0.9	790	7.9	3.8	10.5	0.659	0.330

표1에서 알 수 있는 바와 같이, 실험예1 내지 실험예5는 높은 색순도 (CIE(X) > 0.65)를 가지고, 동시에 내부양자효율값이 높기 때문에 전류발광효율이 향상된다. 또한, 낮은 구동 전압에서 높은 휘도의 빛을 발광하므로 소모 전력이 감소된다.

특히, 실험예5는 액상에서 코팅 방법에 의해 발광층을 형성한 것이며, 구동 전압, 휘도 등에 있어 우수한 효과를 갖는다. 따라서 본 발명의 제 1 실시예에 따른 적색 인광 호스트 물질은 코팅 방법에 의해 대면적 소자의 제조가 가능하다.

- 제 2 실시예 -

본 발명의 제 2 실시예에 따른 적색 인광 호스트 물질은 3,4번 위치에 벤조(benzo)기가 위치하고 6번 위치에 방향족 그룹, 이형고리 그룹, 지방족 그룹 또는 수소로부터 선택된 물질이 치환되며 9번 위치에 페닐(phenyl)기가 치환된 카바졸(carbazol)이 바이페닐(biphenyl)에 대칭적으로 치환됨으로써, 솔루션블한 특성을 갖는 것이 특징이며, 하기 화학식5로 표시된다. 카바졸의 질소는 페닐기의 metha 위치에 치환된다.



상기 화학식5에서 A는 치환 또는 비치환된 방향족 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 이형고리 그룹 물질, 치환 또는 비치환된 지방족 그룹 물질 또는 수소에서 선택된다.

예를 들어, 상기 방향족 그룹 물질은 페닐(phenyl), 나프틸(naphthyl), 바이페닐(biphenyl), 터페닐(terphenyl), 페난스렌릴(phenanthrenyl)을 포함하는 것이 특징이다.

또한, 상기 이형고리 그룹 물질은 피리딘일(pyridinyl), 비피리딘일(bipyridinyl), 퀴놀린일(quinolinyl), 이소퀴놀린일(isoquinolinyl), 퀴녹살린일(quinoxaliny), 터피리딘일(terpyridinyl), 페난스롤린일(phenanthrolinyl)을 포함하는 것이 특징이다.

또한, 상기 지방족 그룹 물질은 C1~C20의 아릴(aryl), C1~C20의 알킬(alkyl)을 포함하는 것이 특징이다.

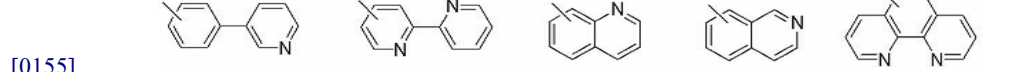
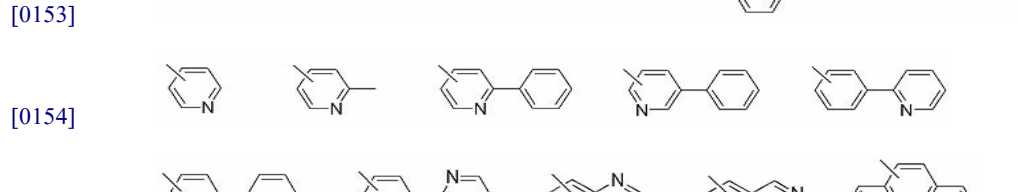
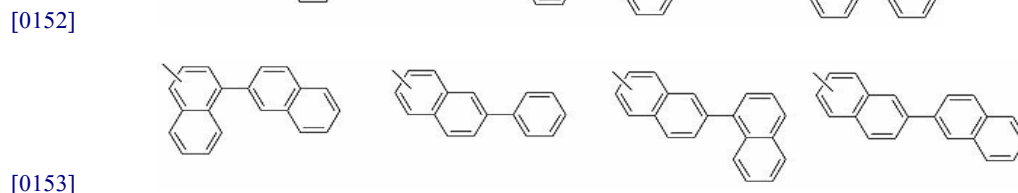
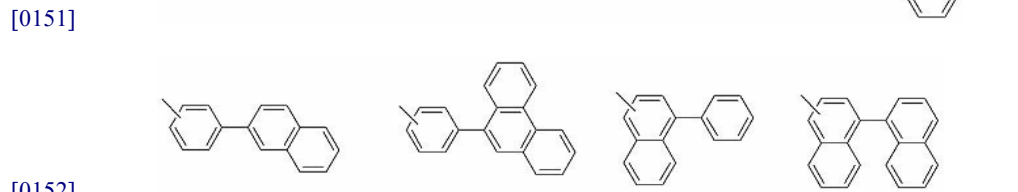
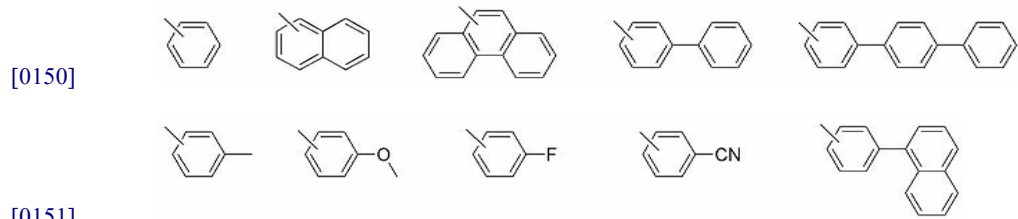
또한, 상기 방향족 그룹 물질, 상기 이형고리 그룹 물질 및 상기 지방족 그룹 물질 각각의 치환체는 C1~C20의 아릴(aryl), C1~C20의 알킬(alkyl), C1~C20의 알콕시(alkoxy), 할로젠(halogen), 시아노(cyano), 실릴(silyl)

중에서 선택되는 것이 특징이다. 예를 들어, 상기 치환체는 메틸(methyl), 에틸(ethyl), 프로필(propyl), 이소프로필(isopropyl), 부틸(t-butyl), 메톡시(methoxy), 에톡시(ethoxy), 부톡시(butoxy), 트리메틸실릴(trimethylsilyl), 불소, 염소 중 어느 하나일 수 있다.

[0147] 즉, 제 2 실시예의 적색 인광 호스트 물질은, 3,4번 위치에 벤조(benzo)기가 위치하고 6번 위치에 방향족 그룹, 이형고리 그룹, 지방족 그룹 또는 수소로부터 선택된 물질이 치환되며 9번 위치에 페닐(phenyl)기가 치환된 카바졸(carbazol)이 바이페닐(biphenyl)에 대칭적으로 치환되며 카바졸의 질소는 페닐기의 meta 위치에 치환됨으로써, 솔루블한 특성을 갖게 된다.

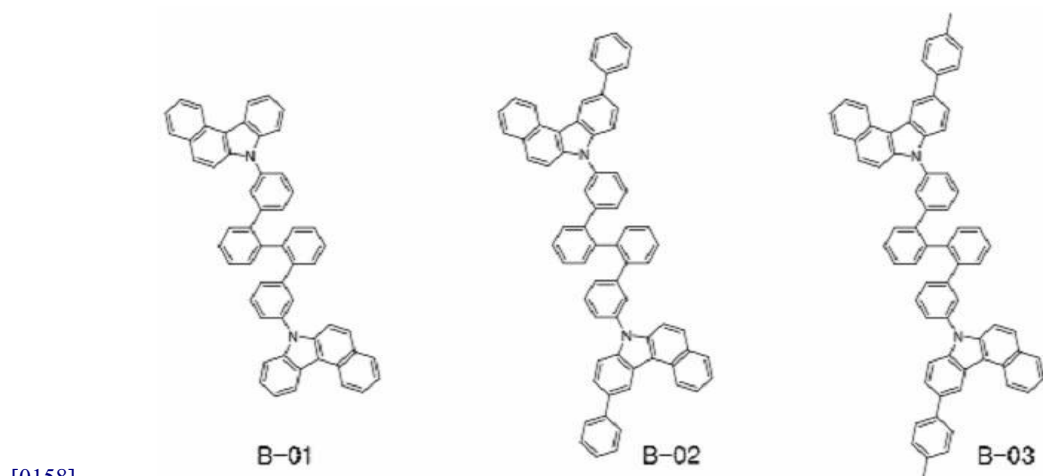
[0148] 예를 들어, 상기 화학식5에서 A는 아래 화학식6으로 표시되는 다수의 물질군으로부터 선택될 수 있다.

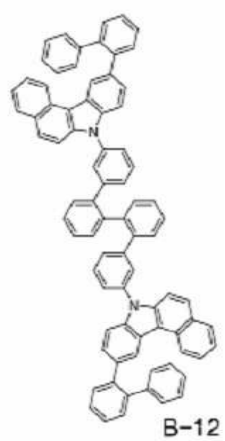
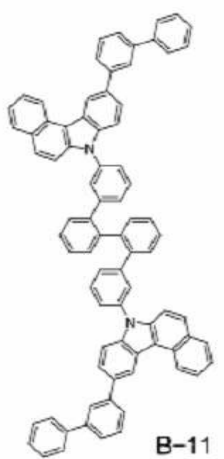
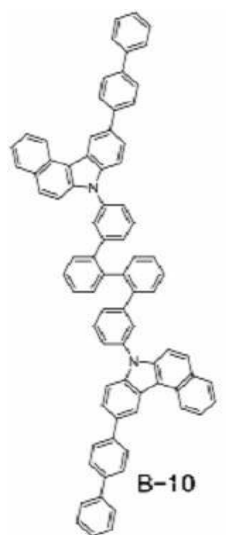
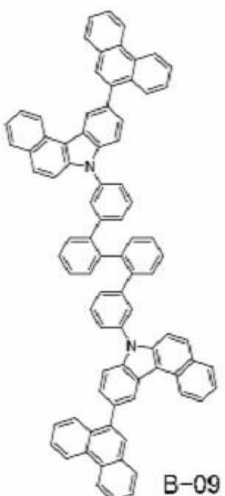
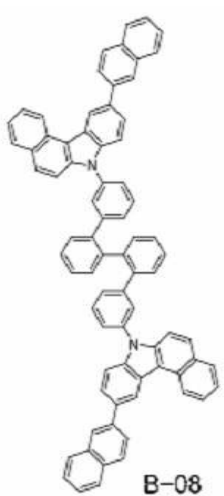
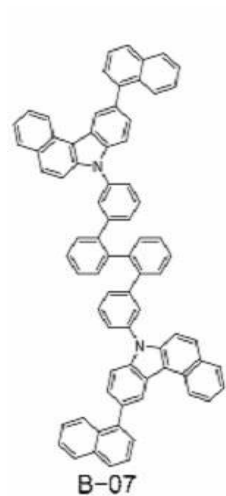
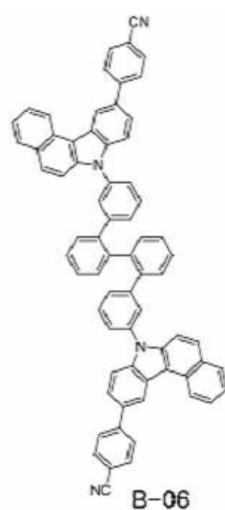
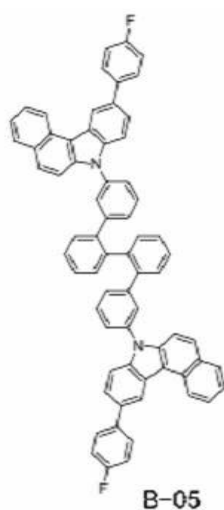
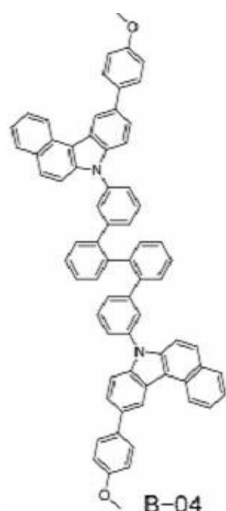
[0149] 화학식6

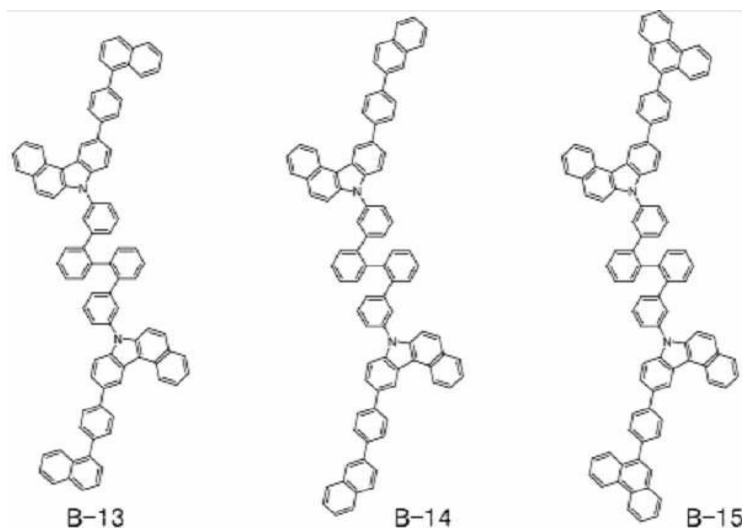


[0155] A의 선택에 따라, 상기 화학식5의 적색 인광 호스트 물질은 하기 화학식7에 표시된 다수의 물질 중 어느 하나가 된다. 여기서, 설명의 편의를 위해 각 물질 하단에 B01~B38의 기호를 부여하였다.

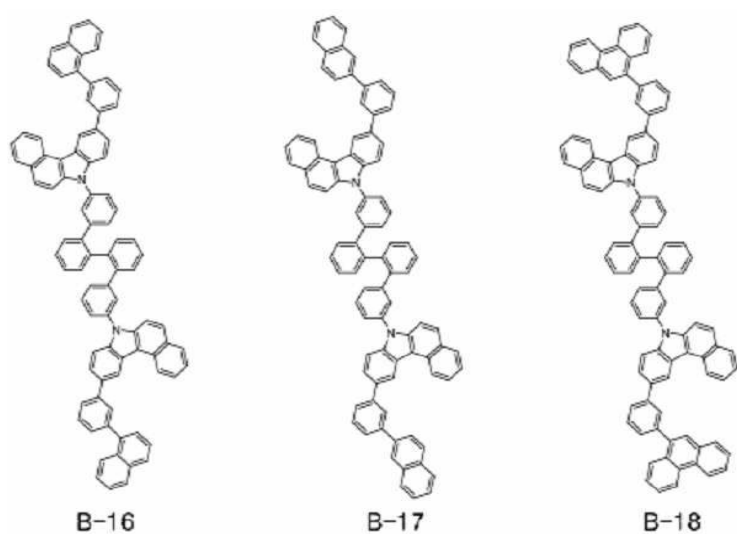
[0157] 화학식7



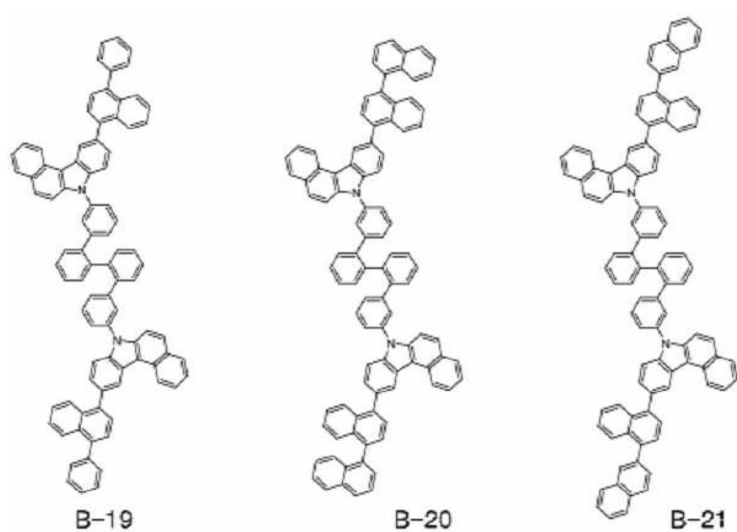




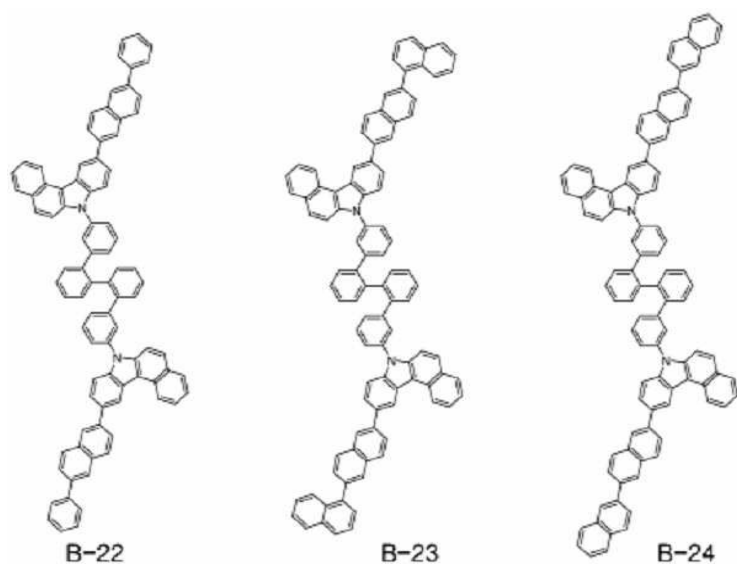
[0162]



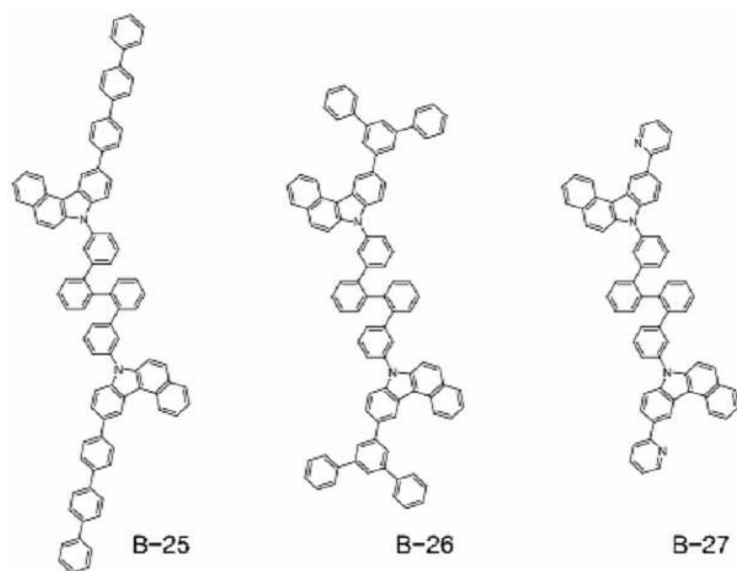
[0163]



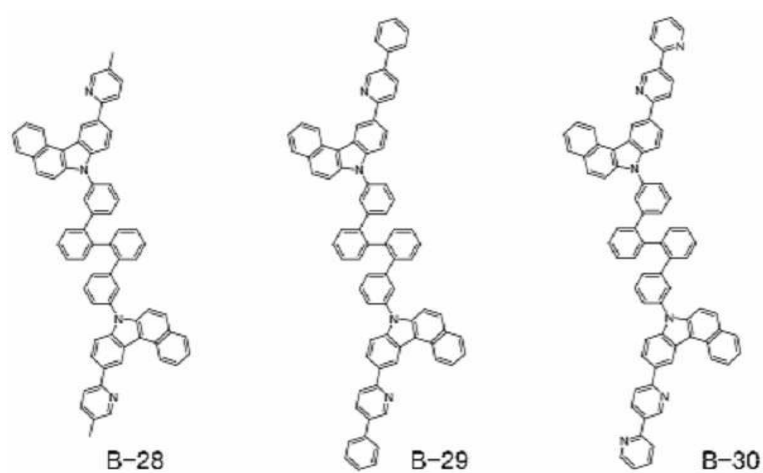
[0164]



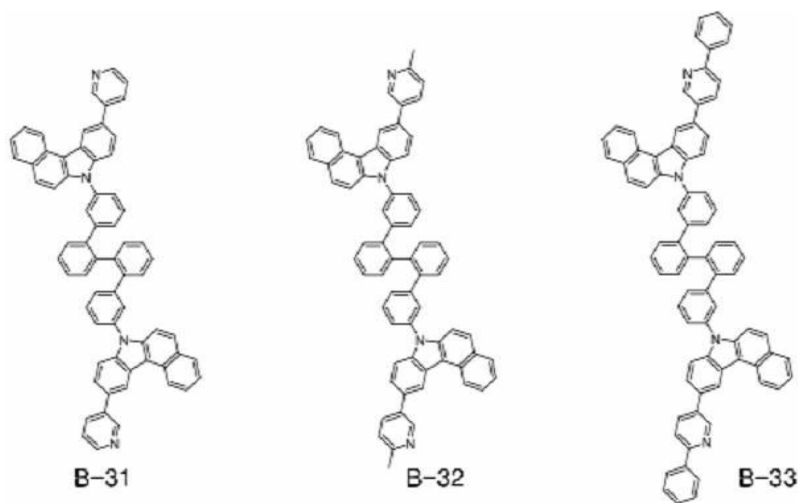
[0165]



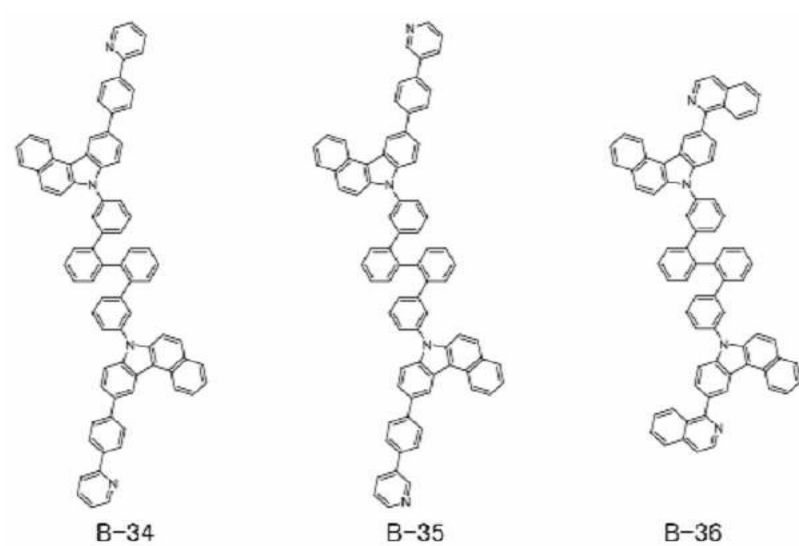
[0166]



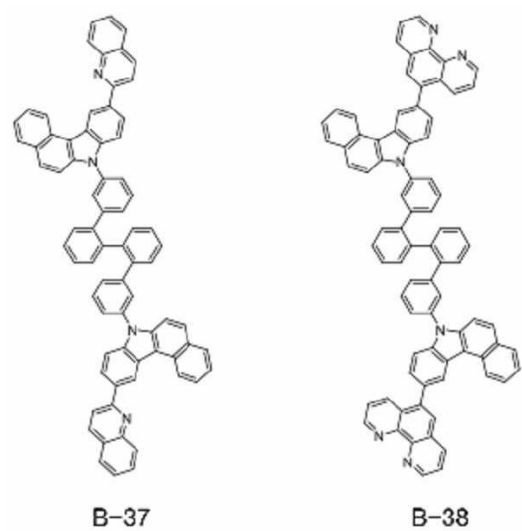
[0167]



[0168]



[0169]



[0170]

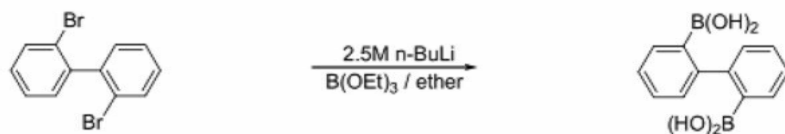
[0171] 이하에서는, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 유기전계발광소자용 적색 인광 호스트 물질 중, 상기 화학식7에서 B-01과 B-02로 표시된 적색 인광 호스트 물질을 예로 들어, 합성예3 및 합성예4를 설명한다.

[0172] 제 3 합성예

[0173] 1. 2,2'-biphenyldiboronic acid의 합성

[0174] 2,2'-biphenyldiboronic acid는 아래와 같은 반응식7에 의해 합성된다.

[0175] 반응식7



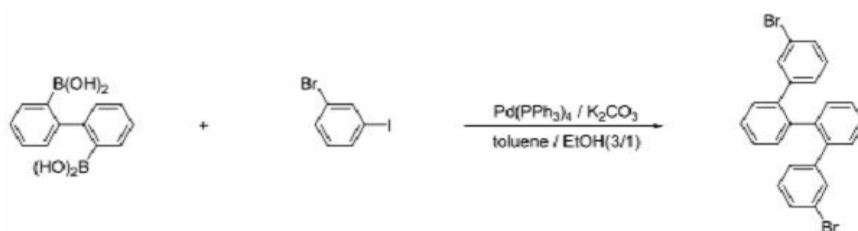
[0176]

[0177] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크에 2,2'-dibromobiphenyl (10g, 0.03mol)과 100mL의 ether를 넣고 교반한다. Dry-ice bath로 온도를 -78℃로 내린 다음, 2.5M n-BuLi (26.9mL, 0.067mol)를 천천히 떨어뜨리고 다시 상온에서 1시간 동안 교반한다. 다시 dry-ice bath로 온도를 -78℃로 내린 다음 triethylborate (19.5g, 0.13mol)를 천천히 떨어뜨리고 다시 상온에서 4시간 동안 교반한다. 100mL의 2N HCl를 넣고 반응을 종료시킨 다음, 용매를 증발시킨다. 생성된 고체를 여과하고, 증류수와 hexane으로 3-4회 세정하여 2,2'-biphenyldiboronic acid (5.4g, yield :70%)을 얻었다.

[0178] 2. 2,2'-bis(3'-bromophenyl)biphenyl의 합성

[0179] 2,2'-bis(3'-bromophenyl)biphenyl은 아래와 같은 반응식8에 의해 합성된다.

[0180] 반응식8



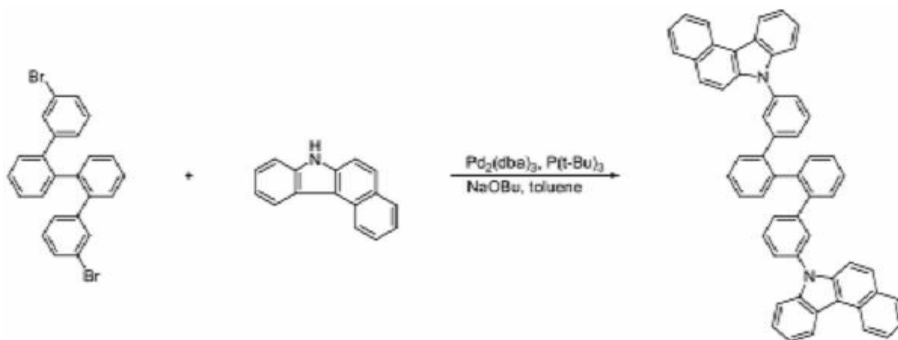
[0181]

[0182] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크에 2,2'-biphenyldiboronic acid (5g, 0.02mol), 1-bromo-3-iodobenzene(12.9g, 0.045mol), Pd(PPh3)4(0.1g, 0.9mmol), K2CO3과 90mL의 toluene/EtOH(3:1)를 넣고 12시간 동안 환류시킨다. 온도를 상온으로 냉각한 다음, methylene chloride로 추출하고, 용매를 증발시킨 후, 실리카 겔 컬럼으로 정제(purification)하여 2,2'-bis(3'-bromophenyl)biphenyl (7.8g, yield :80%)을 얻었다.

[0183] 3. B-01의 합성

[0184] 상기 화학식7에서 B-01로 표시된 적색 인광 호스트 물질은 아래와 같은 반응식9에 의해 합성된다.

[0185] 반응식9



[0186]

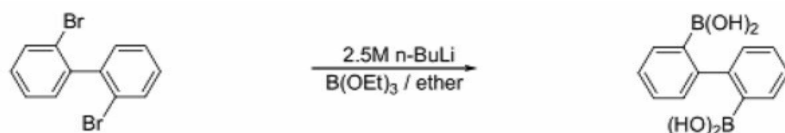
[0187] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크에 2,2'-bis(3'-bromophenyl)biphenyl (1g, 2.1mmol), benzo[3,4]carbazole (1g, 4.7mmol), Pd2(dba)3, P(t-Bu)3, NaOBu(0.6g, 6mmol)와 toluene을 넣고 130℃에서 18시간 동안 환류시킨다. 온도를 상온으로 냉각한 다음, methylene chloride로 추출하고 용매를 증발시킨 후, 실리카겔 컬럼으로 정제하여 B-01(1.1g, yield :70%)을 얻었다.

[0188] 제 4 합성에

[0189] 1. 2,2'-biphenyldiboronic acid의 합성

[0190] 2,2'-biphenyldiboronic acid는 아래와 같은 반응식10에 의해 합성된다.

[0191] 반응식10



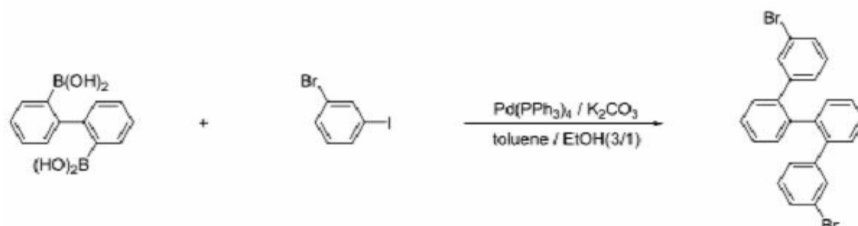
[0192]

[0193] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크에 2,2'-dibromobiphenyl (10g, 0.03mol)과 100mL의 ether를 넣고 교반한다. Dry-ice bath로 온도를 -78℃로 내린 다음, 2.5M n-BuLi (26.9mL, 0.067mol)를 천천히 떨어뜨리고 다시 상온에서 1시간 동안 교반한다. 다시 dry-ice bath로 온도를 -78℃로 내린 다음 triethylborate (19.5g, 0.13mol)를 천천히 떨어뜨리고 다시 상온에서 4시간 동안 교반한다. 100mL의 2N HCl를 넣고 반응을 종료시킨 다음, 용매를 증발시킨다. 생성된 고체를 여과하고, 증류수와 hexane으로 3-4회 세정하여 2,2'-biphenyldiboronic acid (5.4g, yield :70%)을 얻었다.

[0194] 2. 2,2'-bis(3'-bromophenyl)biphenyl의 합성

[0195] 2,2'-bis(3'-bromophenyl)biphenyl은 아래와 같은 반응식11에 의해 합성된다.

[0196] 반응식11



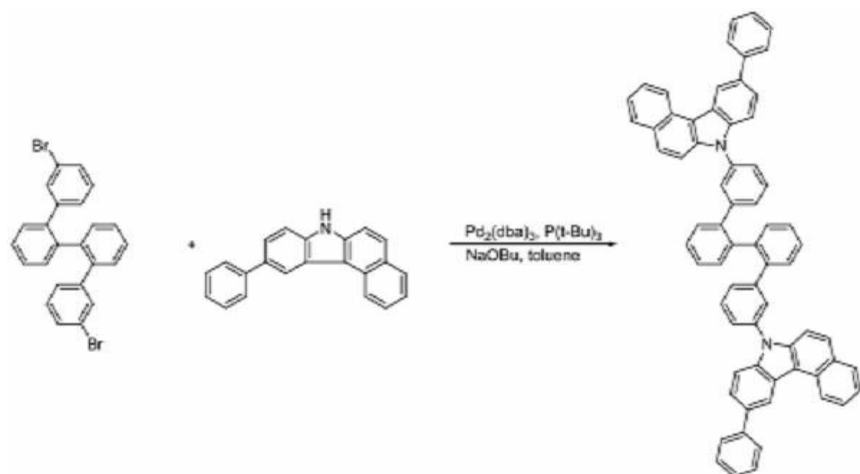
[0197]

[0198] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크에 2,2'-biphenyldiboronic acid (5g, 0.02mol), 1-bromo-3-iodobenzene(12.9g, 0.045mol), Pd(PPh₃)₄(0.1g, 0.9mmol), K₂CO₃과 90mL의 toluene/EtOH(3:1)를 넣고 12시간 동안 환류시킨다. 온도를 상온으로 냉각한 다음, methylene chloride로 추출하고, 용매를 증발시킨 후, 실리카 겔 컬럼으로 정제(purification)하여 2,2'-bis(3'-bromophenyl)biphenyl (7.8g, yield :80%)을 얻었다.

[0199] 3. B-02의 합성

[0200] 상기 화학식7에서 B-02로 표시된 적색 인광 호스트 물질은 아래와 같은 반응식12에 의해 합성된다.

[0201] 반응식12



[0202]

[0203] 구체적으로, 2구 둥근 플라스크에 2,2'-bis(3'-bromophenyl)biphenyl (1g, 2.1mmol), 3-phenylbenzo[3,4]carbazole (1g, 4.7mmol), Pd₂(dba)₃, P(t-Bu)₃, NaOBu(0.6g, 6mmol)와 toluene을 넣고 130 °C에서 18시간 동안 환류시킨다. 온도를 상온으로 냉각한 다음, methylene chloride로 추출하고 용매를 증발시킨 후, 실리카겔 컬럼으로 정제하여 B-02(1.1g, yield :70%)을 얻었다.

[0204] 이하, 상기한 본 발명의 제 2 실시예에 따른 적색 인광 호스트 물질을 이용하여 유기전계발광소자를 제작하는 실험예6 내지 실험예10을 통해, 본 발명에 의한 적색 인광 호스트 물질 및 이를 이용한 유기전계발광소자의 성능을 비교 설명한다.

[0205] 실험예6

[0206] 기관 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 CuPC (650 Å), NPD(400 Å), 상기 화학식7에서 B-01로 표시된 적색 인광 호스트 물질에 상기 화학식1-4로 RD-1로 표시된 도펀트를 5% 첨가한 발광층 (200 Å), Alq3(350 Å), LiF(5 Å), Al(1000 Å)의 순서로 성막하였다.

[0207] 0.9mA에서 1200cd/m²(5.7V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.658, y = 0.326를 나타내었다.

[0208] 실험예7

[0209] 기관 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 CuPC (650 Å), NPD(400 Å), 상기 화학식7에서 B-02로 표시된 적색 인광 호스트 물질에 상기 화학식1-4로 RD-1로 표시된 도펀트를 5% 첨가한 발광층 (200 Å), Alq3(350 Å), LiF(5 Å), Al(1000 Å)의 순서로 성막하였다.

[0210] 0.9mA에서 1250cd/m²(5.7V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.658, y = 0.326를 나타내었다.

[0211] 실험예8

[0212] 기관 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 CuPC (650 Å), NPD(400 Å), 상기 화학식7에서 B-08로 표시된 적색 인광 호스트 물질에 상기 화학식1-4로 RD-1로 표시된 도펀트를 5% 첨가한 발광층 (200 Å), Alq3(350 Å), LiF(5 Å), Al(1000 Å)의 순서로 성막하였다.

[0213] 0.9mA에서 1290cd/m²(5.6V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.658, y = 0.330를 나타내었다.

[0214] 실험예9

[0215] 기관 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 CuPC (650 Å), NPD(400 Å), 상기 화학식7에서 B-11으로 표시된 적색 인광 호스트 물질에 상기 화학식1-4로

RD-1로 표시된 도펀트를 5% 첨가한 발광층 (200Å), Alq3(350Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

0.9mA에서 1310cd/m²(5.6V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.657, y = 0.330를 나타내었다.

실험예10

기판 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 PEDOT:PSS (800Å, spin coating : 3000 rpm, baking condition : 120 °C, for 1hr), 상기 화학식7에서 B-11로 표시된 적색 인광 호스트 물질에 상기 화학식1-4로 RD-1로 표시된 도펀트를 2% 첨가한 발광층 (250 Å, 3000 rpm, baking condition : 100 °C for 30min)로 스핀코팅 한 다음, Alq3(350Å), LiF(5Å) , Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

0.9mA에서 1060cd/m²(6.5V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.657, y = 0.330를 나타내었다.

비교예2

기판 상에 인듐-틴-옥사이드(ITO)층의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 상기 ITO 층 CuPC (650Å), NPD(400Å), 상기 화학식1-3으로 표시된 CBP에 상기 화학식1-4로 RD-1로 표시된 도펀트를 5% 첨가한 발광층 (200Å), Alq3(350Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

0.9mA에서 780cd/m²(7.5V)를 나타내었으며 이때 CIE x = 0.659, y = 0.329를 나타내었다.

상술한 실험예6 내지 실험예10과 비교예2의 비교결과를 아래 표2에 나타내었다. 여기서 전압의 단위는 V, 전류의 단위는 mA, 휘도의 단위는 cd/m², 전류효율의 단위는 cd/A, 전력효율의 단위는 lm/W, 내부양자효율의 단위는 %이다.

표 2

	전압	전류	휘도	전류효율	전력효율	내부양자 효율	CIE(X)	CIE(Y)
실시예1	5.7	0.9	1200	12.0	6.6	17.0	0.658	0.326
실시예2	5.7	0.9	1250	12.5	6.9	17.3	0.658	0.326
실시예3	5.6	0.9	1290	12.9	7.2	17.5	0.658	0.330
실시예4	5.6	0.9	1310	13.1	7.3	17.7	0.657	0.330
실시예5	6.5	0.9	1060	10.6	5.1	15.5	0.657	0.330
비교예1	7.5	0.9	780	7.8	3.3	10.4	0.659	0.329

표2에서 알 수 있는 바와 같이, 실험예6 내지 실험예10은 높은 색순도 (CIE(X) > 0.65)를 가지고, 동시에 내부양자효율값이 높기 때문에 전류발광효율이 향상된다. 또한, 낮은 구동 전압에서 높은 휘도의 빛을 발광하므로 소모 전력이 감소된다.

특히, 실험예10은 액상에서 코팅 방법에 의해 발광층을 형성한 것이며, 구동 전압, 휘도 등에 있어 우수한 효과를 갖는다. 따라서 본 발명의 제 2 실시예에 따른 적색 인광 호스트 물질은 코팅 방법에 의해 대면적 소자의 제조가 가능하다.

상기한 적색 인광 호스트 물질을 포함하여 이루어지는 유기전계발광소자에 대한 일 실시예를 도 2에 도시하였다.

도시한 바와 같이, 유기전계발광소자는 서로 마주보는 제 1 및 제 2 기판(미도시)과, 상기 제 1 및 제 2 기판(미도시) 사이에 형성되어 있는 유기발광다이오드(E)를 포함한다.

상기 유기발광다이오드(E)는 양극 역할을 하는 제 1 전극(110), 음극 역할을 하는 제 2 전극(130) 및 상기 제 1

및 제 2 전극(110, 130) 사이에 형성되는 유기발광층(120)으로 이루어진다.

[0230] 상기 제 1 전극(110)은 일함수 값이 비교적 높은 물질, 예를 들어, 인듐-틴-옥사이드(ITO)로 이루어지며, 상기 제 2 전극(130)은 일함수 값이 비교적 낮은 물질, 예를 들어, 알루미늄(Al) 또는 알루미늄 합금(AlNd)로 이루어진다. 또한, 상기 유기발광층(120)은 적색, 녹색, 청색은 유기발광페턴으로 이루어진다.

[0231] 상기 유기발광층(120)은 발광효율을 극대화하기 위해, 다중층 구조 즉, 제 1 전극(110)으로부터 순차적으로 정공주입층(hole injection layer; HTL) (121), 정공수송층(hole transporting layer; HIL) (122), 발광물질층(emitting material layer; EML) (123), 전자수송층(electron transporting layer)(124) 및 전자주입층(electron injection layer)(125)으로 이루어진다.

[0232] 여기서, 상기 발광물질층(123) 중 상기 화학식2 또는 5로 표시된 적색 인광 호스트 물질을 포함하여 이루어진다. 상기 적색 인광 호스트 물질이 약 1~10wt%로 용매, 예를 들어 자일렌(xylene)에 용해되고, 도펀트가 약 1~10wt% 첨가되어 발광물질층 용액이 제조된다. 상기 발광물질층 용액을 코팅하여 상기 발광물질층(123)을 형성하게 된다. 특히 본 발명의 적색 인광 호스트 물질은 비극성(non-polar) 용매에 대한 용해도가 우수하다. 만약 극성 용매를 이용하여 코팅 공정이 진행된다면 핫 플레이트(hot plate) 등을 이용하여 용매를 증발시키는 경우 용매가 잔존하여 결합으로 작용할 수 있게 된다. 그러나 비극성 용매를 이용할 경우 이러한 문제가 발생하지 않는다. 상기 발광물질층(123)은 녹색, 청색 발광물질층을 더욱 포함할 수 있다.

[0233] 이와 같은 구성의 유기전계발광소자는 발광물질층 용액을 코팅하여 상기 발광물질층(123)을 형성하기 때문에, 대면적 유기전계발광소자의 제조에 장점을 갖는다. 또한, 고휘도의 영상을 구현할 수 있고, 또한 발광효율이 향상되어 저전력구동이 가능하여 소모전력이 감소되는 장점을 갖는다.

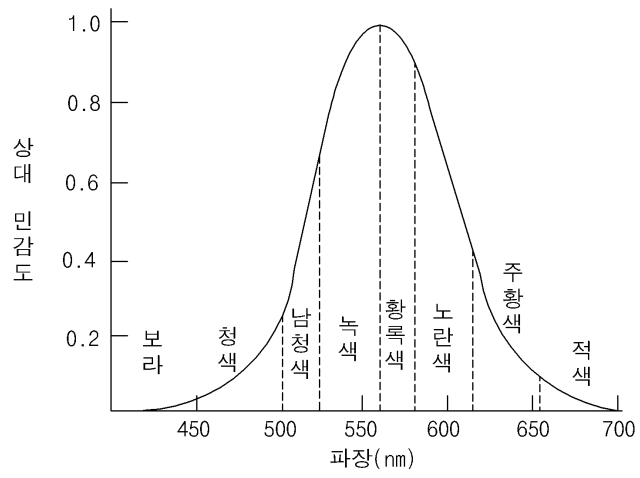
[0234] 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

부호의 설명

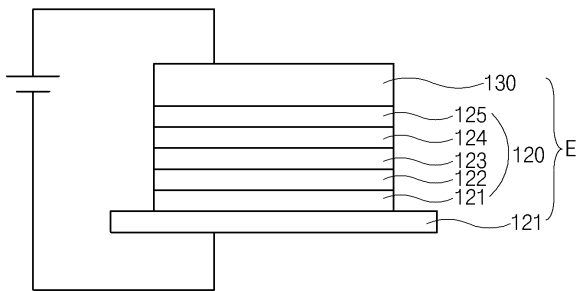
[0235] 110: 제 1 전극
120: 유기발광층
123: 발광물질층
130: 제 2 전극

도면

도면1



도면2



专利名称(译)	标题：红色磷光主体材料和使用其的有机电致发光器件		
公开(公告)号	KR1020120038818A	公开(公告)日	2012-04-24
申请号	KR1020100100484	申请日	2010-10-14
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	JEONG HYUN CHEOL 정현철 LEE SEUNG JAE 이승재 KIM JUNG KEUN 김중근 PARK CHUN GUN 박춘건 BIN JONG KWAN 빈종관 YANG JOONG HWAN 양중환		
发明人	정현철 이승재 김중근 박춘건 빈종관 양중환		
IPC分类号	C09K11/06 H01L51/50		
CPC分类号	H01L51/0072 H01L51/0067 H05B33/20 H01L2251/30 Y10S428/917		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

目的：提供红色磷光主体材料，通过溶液工艺形成薄膜，具有优异的溶解性，从而提供能够体现高亮度图像的大尺寸有机电致发光器件。组成：红色磷光主体材料为化学式1或2。在化学式中，A是取代或未取代的芳族基团材料，取代或未取代的杂环基团材料，取代或未取代的芳族基团细菌，或氢。有机电致发光器件包括第一电极，面对第一电极的第二电极，以及在第一和第二电极之间的发光材料层。发光材料层由红色磷光主体材料组成。COPYRIGHT KIPO 2012

